

請求の範囲

- [請求項1] エポキシ樹脂（A）、エポキシ樹脂硬化剤（B）、フェノキシ樹脂（C）及び無機充填材（D）を含有する接着剤用組成物であって、
前記フェノキシ樹脂（C）の25℃における弾性率が500MPa以上であり、
前記エポキシ樹脂（A）と前記フェノキシ樹脂（C）の各含有量の合計に占める前記フェノキシ樹脂（C）の割合が、10～60質量%であり、
前記接着剤用組成物を用いて形成した、硬化前のフィルム状接着剤の25℃におけるナノインデンテーション硬さが0.10MPa以上、ヤング率が100MPa以上である接着剤用組成物。
- [請求項2] 前記無機充填材（D）の平均粒径（ d_{50} ）が0.01～5.0 μ mであり、
前記エポキシ樹脂（A）、前記エポキシ樹脂硬化剤（B）、前記フェノキシ樹脂（C）及び前記無機充填材（D）の各含有量の合計に占める前記無機充填材（D）の割合が、5～70体積%である請求項1に記載の接着剤用組成物。
- [請求項3] 前記無機充填材（D）が、モース硬度2以上の無機充填材を含む請求項2に記載の接着剤用組成物。
- [請求項4] 前記接着剤用組成物を用いて形成した、硬化前のフィルム状接着剤を25℃から5℃/分の昇温速度で昇温したとき、120℃における溶融粘度が100～10000Pa・sの範囲にある請求項1～3のいずれか1項に記載の接着剤用組成物。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか1項に記載の接着剤用組成物により得られるフィルム状接着剤。
- [請求項6] 厚みが1～60 μ mである、請求項5に記載のフィルム状接着剤。
- [請求項7] 半導体パッケージの製造方法であって、
表面に少なくとも1つの半導体回路が形成された半導体ウェハの裏

面に、請求項5又は6に記載のフィルム状接着剤を熱圧着して接着剤層を設け、前記接着剤層を介してダイシングテープを設ける第1の工程と、

前記半導体ウェハと前記接着剤層とを同時にダイシングすることにより、ダイシングテープ上に、前記半導体ウェハ及び前記接着剤層を備える接着剤層付き半導体チップを得る第2の工程と、

前記接着剤層から前記ダイシングテープを取り除き、前記接着剤層付き半導体チップと配線基板とを前記接着剤層を介して熱圧着する第3の工程と、

前記接着剤層を熱硬化する第4の工程と、

を含む半導体パッケージの製造方法。

[請求項8]

半導体チップと配線基板、又は、半導体チップ間が、請求項5又は6に記載のフィルム状接着剤の熱硬化体により接着されてなる、半導体パッケージ。